



Marco Mezger, Vorstand Sales und Marketing bei Memphis Electronic: „Die Kernkompetenz von Memphis besteht darin, für jedes Design den passenden Speicherbaustein anzubieten. Leistungsfähigkeit ist dabei ebenso ein Kriterium wie Preis und langfristige Verfügbarkeit. Mit unseren Neuentwicklungen reagieren wir auf die Nachfrage unserer Kunden nach Komponenten, die entweder nur von einem Hersteller im Markt angeboten werden oder bereits abgekündigt wurden.“

Die Memphis Electronic AG, ein internationaler Distributor von Speicherkomponenten und Hersteller von Industriespeichermodulen, bringt erstmals eigene Speicher-ICs auf den Markt. Ab sofort sind zwei neue Produktreihen im Portfolio des Speicherspezialisten, ein 1 Gigabit DDR1 sowie ein 2Gbit DDR2-IC. DDR-Speicher mit diesen Kapazitäten werden derzeit nur noch von wenigen Herstellern angeboten oder sind sehr begrenzt verfügbar. Die neuen ICs von Memphis bieten Geräte-Herstellern eine attraktive Alternative für ihr Produktdesign. Damit wird der Spezialdistributor, der bereits Produkte von mehr als 20 Speicherherstellern im Programm hat, selbst zum Anbieter von eigenen Memory-ICs. Der 2,5 Volt DDR1 Baustein ist in einem 66 Pin TSOP untergebracht und verfügt über 1Gbit. Damit verdoppelt Memphis die bisher gängige Kapazität von 512Mbit. Der neue DDR1 richtet sich besonders an Industrie-Computer, die eine hohe Speicherdichte auf kleinem Raum benötigen ebenso wie zum Beispiel hochwertige Telekommunikations-Server für den Mobilfunk. Der DDR1 mit einer Busbreite von 16 Bit ist ab sofort verfügbar. Eine zweite Variante mit 8 Bit ist voraussichtlich ab Dezember 2010 erhältlich. Darüber hinaus arbei-

tet Memphis an einer Version, die den industriellen Temperaturbereich von  $-40$  bis  $+85^{\circ}\text{C}$  abdeckt. Der DDR2 mit 2Gbit arbeitet an 1,8Volt und ist für eine Gehäuse-temperatur von bis zu  $95^{\circ}\text{C}$  ausgelegt. Er ist ab sofort in einer Busbreite von 4, 8 und 16 Bit erhältlich und eignet sich damit für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die 4 und 8 Bit ICs sind in einem  $10,5 \times 11,5\text{mm}$  60-Ball-FBGA untergebracht. Etwas größer ist das 16 Bit-Modell mit  $10,5 \times 12,5\text{mm}$  in einem 84-Ball-FBGA. Der Baustein ist standardmäßig mit bis zu 400 MHz (800 MHz Datenrate) bei einer CAS-Latency von 5 taktbar und entspricht damit selbst den höchsten Geschwindigkeitsanforderungen. Bis Ende des Jahres wird das DRAM auf eine Datenrate von 1066 MHz bei CL7 optimiert. Darüber hinaus plant man, eine Version mit erweitertem Temperaturbereich von  $-40$  bis  $+95^{\circ}\text{C}$  zu qualifizieren. Eine Automotive-Version mit noch höheren Temperaturen ist für 2011 geplant. Die neuen Produkte sind bereits in Mustern über Memphis Electronic erhältlich.



Halle A5 Stand 339



infoDIRECT434e/1110

▶ Link zu Memphis

[www.elektronik-industrie.de](http://www.elektronik-industrie.de)